

## 特長

- i線（ブロードバンド可）で露光・現像によって直接パターンニング可能
- 優れた透明性（98%以上）
- 優れた絶縁性
- 優れた耐熱性
- シリコン, ガラスとの強固な密着
- ハードコートとしても使える硬度(4H)

## 応用例

- 半導体, LCD, OLED 用 層間絶縁膜
- CVD-SiO<sub>2</sub>の代替

## 使用方法

基板洗浄→塗布（スピコート/スリットコート）→ プリベーク(100℃ x 3 min) → 露光(200 mJ/cm<sup>2</sup>) → 露光後ベーク (PEB) (120℃ x 3 min) → 現像 (2.38% TMAH aq., 1 min) → リンス → キュアベーク(230~400℃ x 30 min)

## 特性表

主溶剤	PGMEA	絶縁耐圧 (電界強度)	~ 1.9 MV/cm @ 1 μA	
固形分量	5~30 wt% (調節可)	誘電率	4.2~4.7	
薬液寿命	6ヶ月 (4℃保存)	密着性	ガラス	5B (100%剥がれ無)
粘度 (20℃)	2.5 mPa·s (13 wt%品)		Si	5B (100%剥がれ無)
最大膜厚	2 μm	薬液耐性	PGMEA	変化なし
屈折率	1.40 @ 550 nm		5% KOH 80℃	溶解
透過率	99~100% (400~800 nm)		2.38%TMAH;20℃	変化なし
鉛筆硬度	8H (ガラス基板上)	耐熱性	5% 膜厚減少	400℃

## 開発・製造元

開発：マックス電子材料株式会社

製造：ラサ工業株式会社